

بررسی تأثیر هافنیوم دی بوراید بر ریزساختار کامپوزیت‌های پایه ZrB₂ سینتر شده به روش SPS

زهره بلک^۱، محمد ذاکری^۲، محمدرضا رحیمی‌پور^۲، اسماعیل صلاحی^۲، میلاد کرمانی^۲

^۱ گروه مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ^۲ پژوهشگاه مواد و انرژی

zbalak1983@gmail.com

چکیده:

سینتر با جرقه پلاسمما (SPS) فرآیندی است که طی سال‌های اخیر برای سرامیک‌های فوق دما بالا به کار گرفته می‌شود. در این پژوهش کامپوزیت‌های پایه ZrB₂ با HfB₂ درصدی مختلف (۰-۱۵ Vol-%) با استفاده از فرآیند SPS در دماها (۱۶۰۰-۱۹۰۰ °C)، زمان‌ها (۱-۱۰ min) و فشارهای (۱۰-۴۰ MPa) سینتر شدند. به علاوه تأثیر ZrB₂ بر نفوذ Hf در Zr مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی ریزساختار و نوع فازهای تشکیل شده بررسی‌های ریزساختاری با استفاده از SEM و شناسایی فازها با استفاده از آنالیز نقطه‌ای و خطی انجام شد. تأثیر دما، زمان و فشار فرآیند SPS بر ریزساختار کامپوزیت نهایی و فازهای تشکیل شده در آن، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که Hf و Zr در هم نفوذ نموده و تشکیل محلول جامد (Zr, Hf)B₂ می‌دهند. همچنین مشخص شد که با افزایش دما و زمان سینتر، میزان نفوذ و در نتیجه محلول جامد افزایش می‌یابد. به علاوه مشخص شد که فشار تأثیر بسیار کمتری نسبت به دما و زمان بر فرآیند نفوذ دارد. نتایج آنالیز خطی نشان داد که خضور MoSi₂ سبب تشکیل یک فاز مایع شده که به نوبه خود سبب تسهیل فرآیند نفوذ Hf و Zr در هم می‌شود. همچنین مشخص شد که افزودن HfB₂ سینترپنیری ZrB₂ را بهبود نداده و به میزان اندکی سبب افزایش درصد تخلخل‌های باز می‌شود.

اطلاعات مقاله:

درایافت: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
پذیرش: ۲۰ تیر ۱۳۹۴

کلید واژه:

سینتر با جرقه پلاسمما، دی بوراید زیرکونیوم، دی بوراید هافنیوم، ریزساختار

شناخته می‌شوند. در میان خانواده سرامیک‌های فوق دما بالای فلزات واسطه، دی بورایدهایی چون ZrB₂ و HfB₂ دارای ترکیب منحصر بفردی از خواص مکانیکی و فیزیکی چون نقطه ذوب بالا (بیش از ۳۰۰۰ °C)، هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، بی‌اثری شیمیایی در مقابل فلزات مذاب و مقاومت به شوک حرارتی بالا می‌باشند. بنابراین با وجود این که کاربیدها بالاترین نقطه‌های ذوب (بیش از ۳۵۰۰ °C) را دارند، اما دی

۱- مقدمه

سرامیک‌های مبتنی بر بورایدها، نیتریدها و کاربیدهای فلزهای واسطه، نقطه ذوب‌های (بیش از ۲۵۰۰ °C) بسیار بالایی دارند و تحت عنوان سرامیک‌های فوق دما بالا^۱ (UHTCs) شناخته می‌شوند. در میان خانواده سرامیک‌های فوق دما بالای فلزات واسطه، نقطه ذوب‌های (بیش از ۲۵۰۰ °C) بسیار بالایی دارند و تحت عنوان سرامیک‌های فوق دما بالا^۱ (UHTCs)

^۱ Ultra-High Temperature Ceramics (UHTCs)



آن گرمادهی به طور غیرمستقیم و با استفاده از میدان الکتریکی بالا در محدوده زمانی بسیار کوچک است و همین امر سبب تشکیل قطعات یکنواخت با چگالی مناسب می‌گردد^[7]. به همین منظور در این پژوهش از SPS جهت چگالش استفاده شده است. تاکنون افزودنی‌های مختلفی چون HfC , AlN , ZrN , ZrB_2 [8] جهت بهبود خواص مکانیکی این سرامیک مورد مطالعه قرار گرفته اند. با توجه به هدایت حرارتی بالاتر HfB_2 نسبت به ZrB_2 به منظور بهبود مقاومت به شوک حرارتی به عنوان افزودنی انتخاب شد که در این تحقیق به بررسی تأثیر HfB_2 بر ریزساختار و سینترپذیری کامپوزیت‌های پایه ZrB_2 پرداخته می‌شود.

۲- فعالیت‌های تجربی

با توجه به این که هدف از انجام این پژوهه رسیدن به قطعه کامپوزیتی با خواص مکانیکی بینه بود، تمامی فاکتورهای موثر در خواص مکانیکی کامپوزیت نهایی مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مطالعه اولیه ۹ فاکتور درصد حجمی اجزاء گرفتند. این فاکتورها در چهار سطح تعريف شد. جدول ۱ این فاکتورهای موثر به همراه سطوح آنها را نشان می‌دهد.

بورایدهای ZrB_2 و HfB_2 کاندیدهای جذاب‌تری برای کاربردهای سازه‌ای دما بالا در دماهای بالاتر یا مساوی $2000^{\circ}C$ هستند^[1-5]. با توجه به چگالی کمتر ZrB_2 $6/0.9\text{ g/cm}^3$ نسبت به HfB_2 $11/3\text{ g/cm}^3$ و به هزینه کمتر آن، طی سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. متأسفانه نظریه بسیاری از سرامیک‌های دیرگداز کووالانتسی، به خاطر حضور پیوند کووالانتسی قوی و پایین بودن ضریب نفوذ در خود، سینتر کردن ZrB_2 تا چگالی‌های بالا بسیار دشوار می‌باشد. به علاوه حضور ناخالصی‌های اکسیدی روی سطح ذرات پودر، متراکم کردن این ماده را در فرآیند سینتر کردن به تأخیر می‌اندازد.

در نتیجه برای متراکم نمودن این ماده به روش‌های متداول، دماهای سینترینگ خیلی بالا مورد نیاز است. SPS فرآیندی است که جهت ساخت قطعات با کیفیت، و در زمان بسیار کمتر نسبت به دیگر روش‌ها به کار می‌رود. این فرآیند امکان ساخت قطعات با استحکام و خواص مکانیکی بالا را فراهم می‌سازد. این تکنولوژی در زمینه‌های گوناگونی از جمله هوا-فضا، نظامی، مهندسی پزشکی، صنایع الکترونیک، نفت و گاز، ساخت پره‌های توربین و بسیاری دیگر از صنایع کاربرد دارد.

این فرآیند ترکیب اعمال نیروی مکانیکی و جریان الکتریکی به طور همزمان است. اگرچه SPS مشابه HP است ولی در

جدول ۱ - فاکتورها و سطوح مورد مطالعه در سینتر کامپوزیت پایه ZrB_2 .

TEST	FAC.1	FAC.2	FAC.3	FAC.4	FAC.5	FAC.6	FAC.7	FAC.8	FAC.9
	SiC Vol%	C _f Vol%	Milling Time (hr)	MoSi ₂ Vol%	HfB ₂ Vol%	ZrC Vol%	Temperature (°C)	Pressure (MPa)	Time (min)
Lev.1	5	0	0	0	0	0	1600	10	4
Lev.2	10	2.5	2.5	2	5	5	1700	20	8
Lev.3	15	5	5	4	10	10	1800	30	12
Lev.4	20	7.5	7.5	6	15	15	1900	40	16



مشخص شدن ۹ فاکتور ۴ سطحی (جدول ۱) با استفاده از نرم افزار Qualitek-4 تعداد آزمایش های مورد نیاز و شرایط هر آزمایش تعیین گردید (جدول ۲).

به منظور بررسی تمامی فاکتورهای مشخص شده در جدول ۱ بهمراه کلیه سطوح آنها، نیاز به انجام تعداد بسیار زیادی آزمایش می باشد که عملاً غیر ممکن است. به همین منظور از طراحی آزمایش به روش تاگوچی استفاده شد. پس از

جدول ۲- شرایط انجام هر آزمایش براساس فاکتور و سطوح مورد مطالعه (تعیین شده به کمک نرم افزار QUALITEK-4).

TEST	FAC.1	FAC.2	FAC.3	FAC.4	FAC.5	FAC.6	FAC.7	FAC.8	FAC.9
	SiC Vol%	C _f Vol%	M.t (hr)	MoSi ₂ Vol%	HfB ₂ Vol%	ZrC Vol%	Temperature (°C)	Pressure (MPa)	Time (min)
1	5	0	0	0	0	0	1600	10	4
2	5	2.5	2.5	2	5	5	1700	20	8
3	5	5	5	4	10	10	1800	30	12
4	5	7.5	7.5	6	15	15	1900	40	16
5	10	0	0	2	5	10	1800	40	16
6	10	2.5	2.5	0	0	15	1900	30	12
7	10	5	5	6	15	0	1600	20	8
8	10	7.5	7.5	4	10	5	1700	10	4
9	15	0	2.5	4	15	0	1700	30	16
10	15	2.5	0	6	10	5	1600	40	12
11	15	5	7.5	0	5	10	1900	10	8
12	15	7.5	5	2	0	15	1800	20	4
13	20	0	2.5	6	10	10	1900	20	4
14	20	2.5	0	4	15	15	1800	10	8
15	20	5	7.5	2	0	0	1700	40	12
16	20	7.5	5	0	5	5	1600	30	16
17	5	0	7.5	0	15	5	1800	20	12
18	5	2.5	5	2	10	0	1900	10	16
19	5	5	2.5	4	5	15	1600	40	4
20	5	7.5	0	6	0	10	1700	30	8
21	10	0	7.5	2	10	15	1600	30	8
22	10	2.5	5	0	15	10	1700	40	4
23	10	5	2.5	6	0	5	1800	10	16
24	10	7.5	0	4	5	0	1900	20	12
25	15	0	5	4	0	5	1900	40	8
26	15	2.5	7.5	6	5	0	1800	30	4
27	15	5	0	0	10	15	1700	20	16
28	15	7.5	2.5	2	15	10	1600	10	12
29	20	0	5	6	5	15	1700	10	12
30	20	2.5	7.5	4	0	10	1600	20	16
31	20	5	0	2	15	5	1900	30	4
32	20	7.5	2.5	0	10	0	1800	40	8

پژوهشگاه با سرعت ۲۰۰ rpm به مدت ۳ ساعت آسیاب شدند. پس از آسیاب، پودرها خشک شده و مخلوط پودری حاصله درون قالب گرافیتی استوانه‌ای شکل که با ورقه

مشخصات پودرهای اولیه در جدول ۳ ارائه شده است. به منظور کاهش اندازه ذرات و ایجاد اختلاط بهتر با افزودنی‌ها مخلوط پودرها پس از توزین، توسط آسیاب سیارهای واقع در



دارای بیشترین میزان زیرکونیوم است. در کامپوزیت ۲۲ نیز فاز خاکستری دارای بیشترین میزان زیرکونیوم (طیف شماره ۲) و فاز متمایل به سفید بیشترین میزان هافنیوم (طیف شماره ۱) می‌باشدند. به دلیل عدم امکان تعیین دقیق میزان بور و کربن و در نتیجه عدم تشخیص دقیق فازهای چون ZrB₂, ZrC و HfB₂ با استفاده از آنالیز نقطه‌ای، به منظور شناسایی دقیق‌تر فازها، علاوه بر آنالیز نقطه‌ای از آنالیز خطی استفاده شد. شکل ۳ آنالیز خطی کامپوزیت ۲۲ را نشان می‌دهد.

با توجه به آنالیزهای EDAX و نقطه‌ای (شکل‌های ۲ و ۳) مشخص است که دانه‌های سیاه رنگ (به دلیل میزان بالای Si در این نقاط از یک طرف و جرم اتمی پایین SiC از طرف دیگر) فاز SiC می‌باشند. با توجه به میزان بالای ZrB₂ در دانه‌های خاکستری تیره و عدم وجود HfB₂ در آن‌ها، این دانه‌ها، فاز ZrB₂ خالص می‌باشند. به علاوه با بررسی دقیق ریزساختار تمامی کامپوزیت‌ها سه فاز با رنگ‌های سفید، سفید متمایل به خاکستری و خاکستری را می‌توان مشاهده نمود. فاز سفید رنگ، HfB₂ تقریباً خالص می‌باشد که در کامپوزیت ۷ به وضوح مشاهده می‌شود. فاز سفید متمایل به خاکستری محلول جامد (Zr, Hf)B₂ می‌باشد که در کامپوزیت‌هایی چون ۸ و ۲۲ به خوبی دیده می‌شود. با توجه به دیاگرام فاز دوتایی ZrB₂-HfB₂ نتیجه‌گیری می‌شود که HfB₂ با هر نسبتی در ZrB₂ حل شده و تشکیل محلول جامد می‌دهد [۱۰]. آنالیز خطی نیز حضور دو فاز ZrB₂ و HfB₂ را به طور همزمان در این نواحی نشان می‌دهد که مؤید این مطلب می‌باشد (شکل ۳). به علاوه فاصله بین صفحات (d) با استفاده از نرم‌افزار

گرافیتی پوشش داده شده، شارژ شده و سپس درون محفظه SPS قرار گرفتند. فرآیند SPS با استفاده از دستگاه مدل SPS-20T-10 انجام شد. دما، زمان و فشار اعمالی هر نمونه با توجه به طراحی آزمایش صورت گرفته، انجام شد.

جدول ۳- مشخصات مواد اولیه.

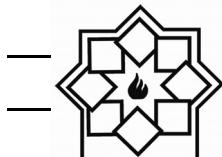
نوع پودر	متوسط اندازه دانه/ قطر μm
ZrB ₂	۲۰
SiC	۲۵
C _f الیاف کربن،	۱۸۰۰ ۵
MoSi ₂	۲۵
HfB ₂	۳۰
ZrC	۲۰

سپس به منظور برداشتن لایه گرافیتی روی سطح نمونه‌ها، پولیش با سنگ الماسه انجام شد. جهت بررسی‌های ریزساختاری، نمونه‌ها توسط واپرکات با سیم به ضخامت ۰/۴mm بشش داده شد. چگالی بالک نمونه‌های سینتر شده به روش ارشمیدس در آب مقطر و براساس استاندارد ASTM C 373-88 اندازه‌گیری شد [۹].

۳- نتایج و بحث

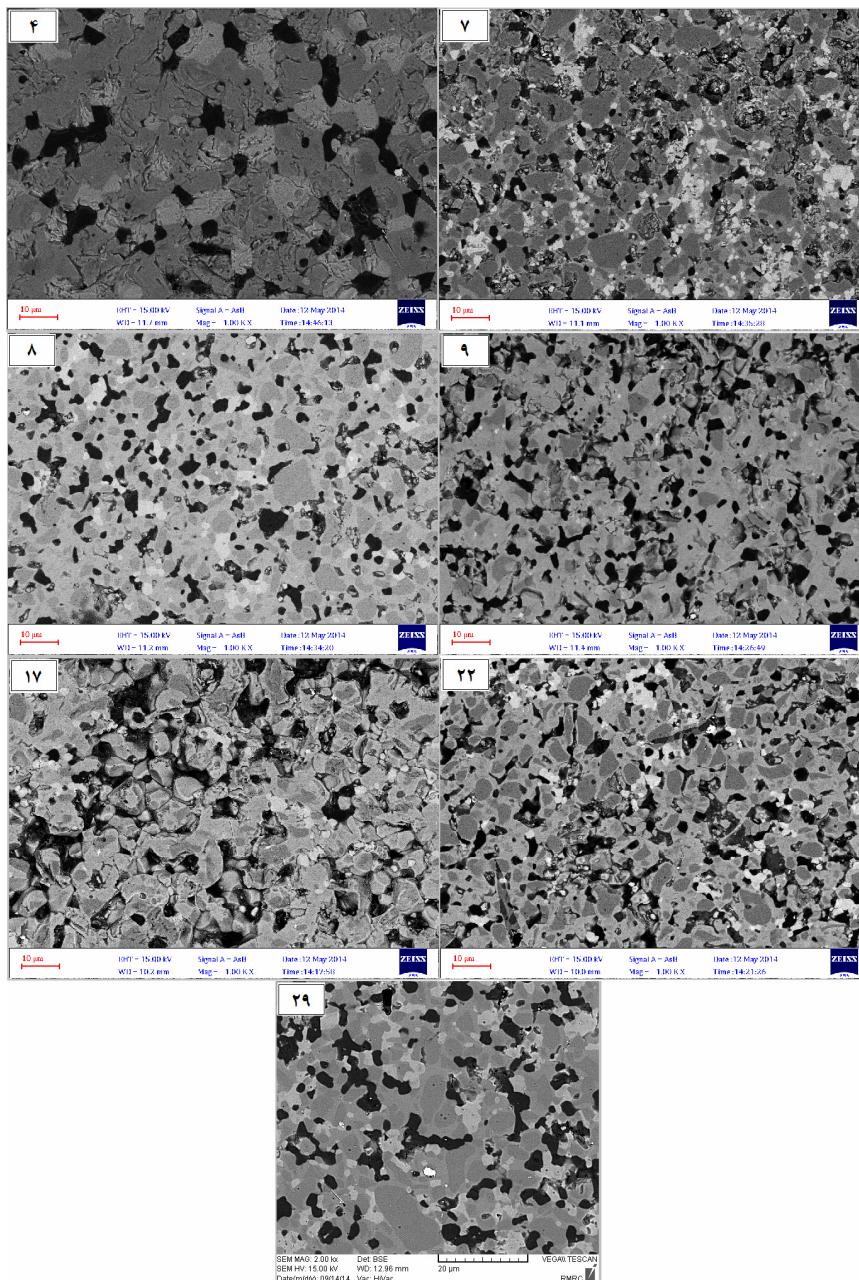
۳-۱- بررسی‌های ریزساختاری

شکل ۱ تصاویر SEM تعدادی از کامپوزیت‌ها را نشان می‌دهد. به منظور شناسایی فازها در ریزساختار از آنالیز EDS استفاده شد. شکل ۲ آنالیز EDS کامپوزیت‌های ۱۱ و ۲۲ را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که فازهای روش D و E که با فلاش در ریزساختار مشخص شده‌اند، دارای میزان هافنیوم بیشتری می‌باشند. به علاوه مشاهده می‌شود که فاز C دارای بیشترین میزان سیلیسیوم می‌باشد. فاز B نیز

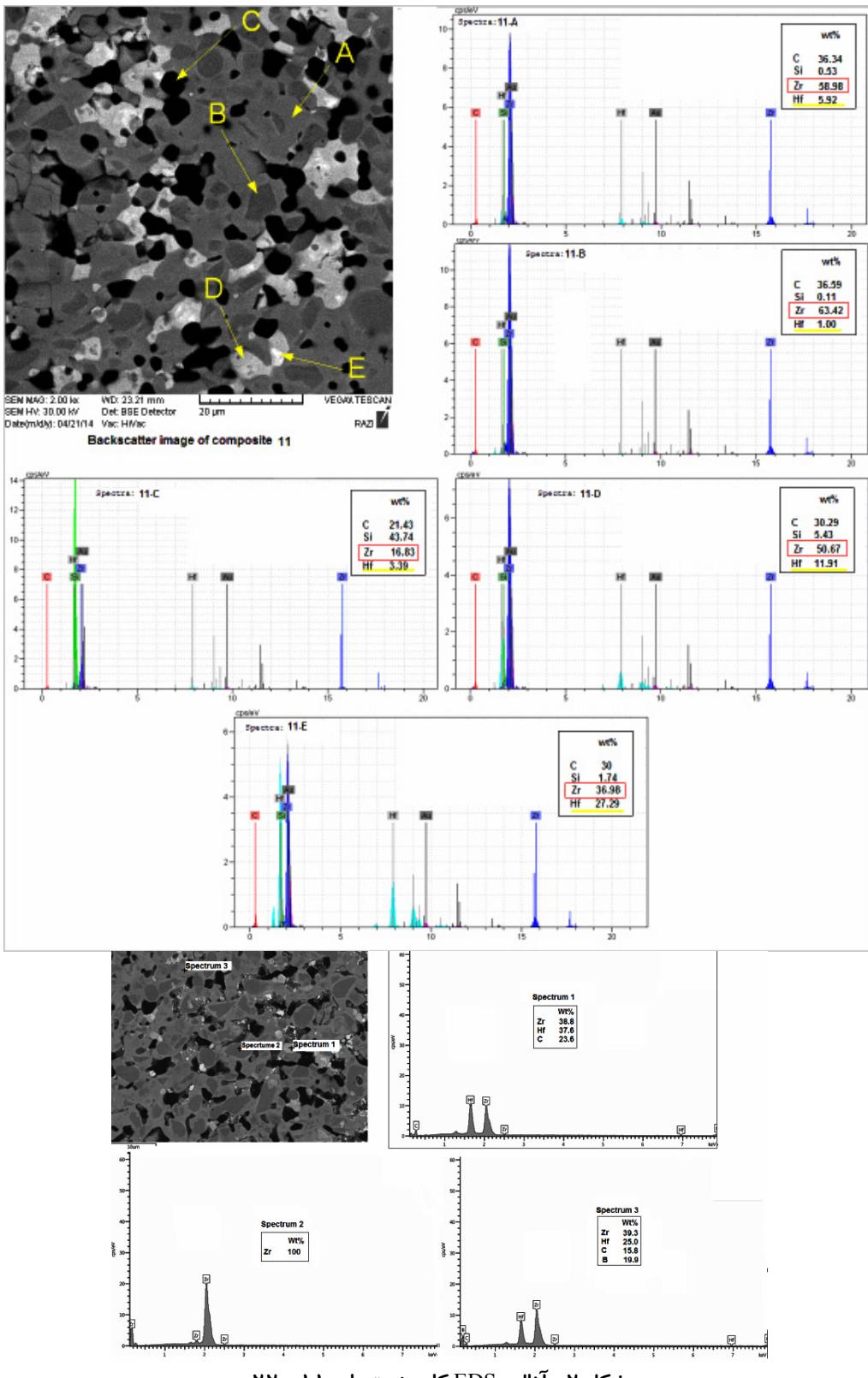


داد که با افزایش میزان Hf در کامپوزیت ۱۸ نسبت به ۵ شبکه کریستالی ZrB₂ دچار انقباض می‌شود. $c_{18}=525 \cdot 57 A^0$, $a_5=3/168247 A^0$, $c_5=3/53 \cdot 553 A^0$ ZrB₂-HfB₂ در $a_{18}=3/1636.9 A^0$ که بیانگر اتحال ZrB₂ برای دو کامپوزیت ۵ و ۱۸ باشد.

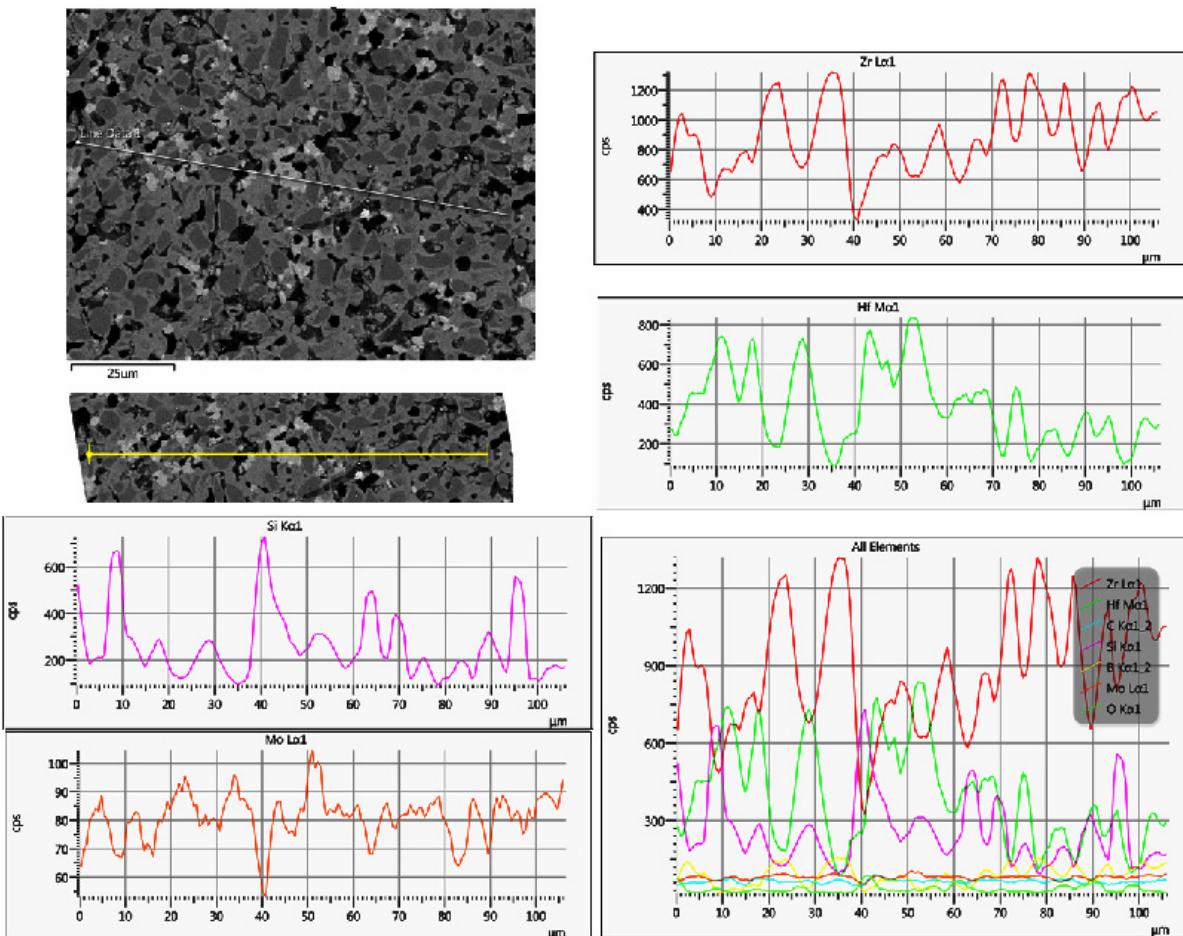
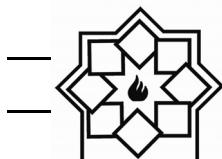
Xpert معین شد. با توجه به نتایج حاصله $d_{18}=2/16375 A^0$, $d_5=2/16555 A^0$ مشاهده می‌شود که فاصله صفحات در کامپوزیت ۱۸ نسبت به ۵ کاهش یافته است. همچنین پارامتر شبکه ZrB₂ برای دو کامپوزیت ۵ و ۱۸ با استفاده نرم‌افزار Maud اندازه‌گیری شد. نتایج نشان



شکل ۱- تصاویر SEM کامپوزیت‌های ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۹



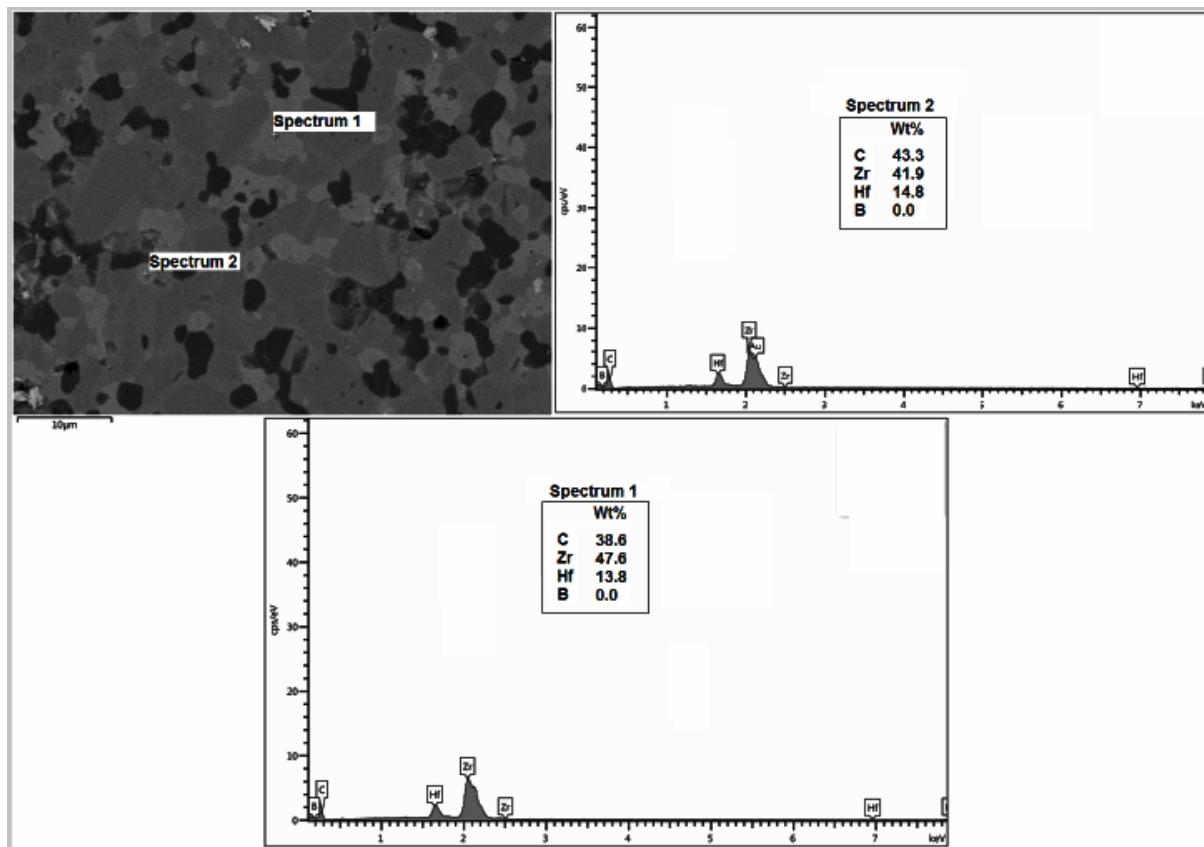
شکل ۲- آنالیز EDS کامپوزیت‌های ۱۱ و ۱۲



شکل ۳- آنالیز خطی کامپوزیت ۲۲

جهت نفوذ Hf و Zr در هم فراهم باشد) می‌باشد. البته همان گونه که در بالا اشاره شد، با توجه به حضور عناصر سبکی چون کربن و بور در آنها، امکان شناسایی دقیق آن‌ها با آنالیز نقطه‌ای مشکل می‌باشد. به عنوان مثال در کامپوزیت^۴، تشخیص این دو فاز از هم بسیار مشکل می‌باشد (شکل ۱). امکان شناسایی فاز MoSi_2 در ریزساختار به دلیل مقدار کم و کنتراست فازهای موجود از یک سو، و انحلال آن در ZrB_2 از سوی دیگر مشکل می‌باشد. در ادامه این موضوع بررسی شده است.

با توجه به جرم اتمی ZrC ۱۲۰ و تصاویر SEM ارائه شده توسط سایر محققین [۱۱-۱۲] این فاز به رنگ خاکستری روشن مشاهده می‌شود. آنالیز نقطه‌ای کامپوزیت ۲۹ (شکل ۴) نیز این مطلب را تأیید می‌نماید. از سوی دیگر فاز ZrB_2 خالص در اثر انحلال کامل HfB_2 در آن و تشکیل محلول جامد به رنگ خاکستری روشن مشاهده می‌شود. از این رو دانه‌های خاکستری روشن در کامپوزیت‌هایی که به طور همزمان حاوی ZrC و HfB_2 هستند، معرف فاز ZrC یا $(\text{Zr}, \text{Hf})\text{B}_2$ (البته در شرایطی که دما و زمان فرآیند

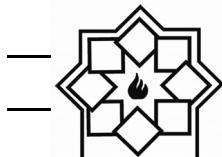


شکل ۴- آنالیز نقطه‌ای کامپوزیت ۲۹

خطی استفاده شد. شکل ۵ آنالیز خطی تمامی این کامپوزیت‌ها را نشان می‌دهد. با مقایسه آنالیز خطی کامپوزیت‌های ۴ و ۹ مشاهده می‌شود که در کامپویت ۴ شدت پیک‌های Zr و Hf در تمامی کامپوزیت، تقریباً با هم برابر هستند، در حالی که در کامپوزیت ۹ در قسمت‌هایی از کامپوزیت (به عنوان مثال در حدود ۲۰، ۵۰ و ۶۰ میکرون)، اختلاف بین شدت پیک‌های Hf و Zr زیاد می‌باشد. علت این امر میزان حلالیت بسیار کمتر Hf در این Zr کامپوزیت نسبت به کامپوزیت ۴ می‌باشد. به علاوه با توجه به تصویر BSE این کامپوزیت‌ها (شکل ۱) مشاهده می‌شود که در کامپوزیت ۴ به جای مشاهده دانه‌های خاکستری

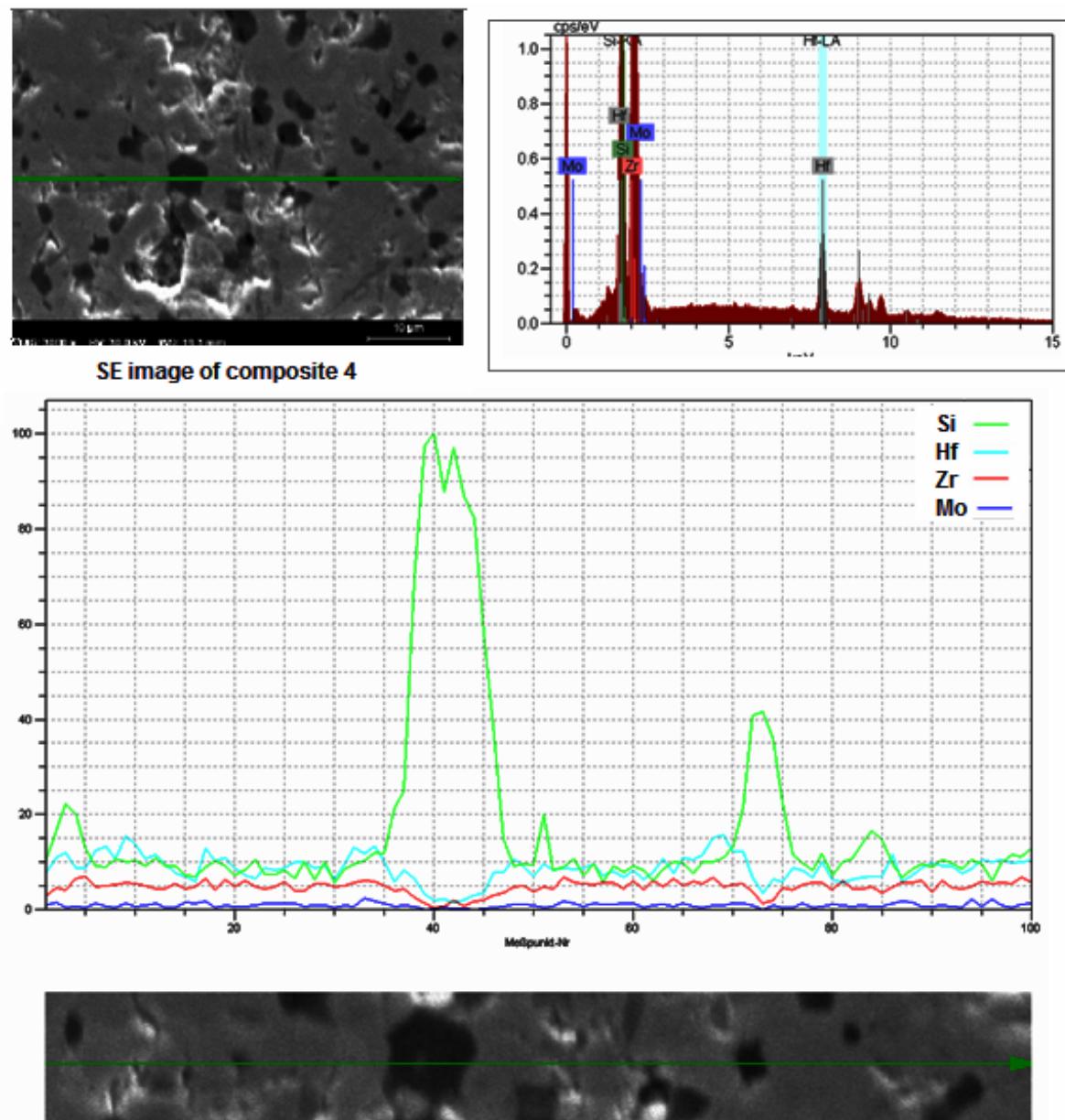
۲-۳- تأثیر دما بر حلایت HfB_2

با مقایسه تصاویر SEM تمامی کامپوزیت‌ها مشاهده می‌شود که در بعضی از کامپوزیت‌ها میزان دانه‌های خاکستری رنگ زیاد (کامپوزیت ۷) و بعضی کم (کامپوزیت ۹) و در تعدادی بسیار کم (کامپوزیت ۴) می‌باشد. همچنین مشاهده می‌شود که در بعضی کامپوزیت‌ها (کامپوزیت ۴) علی‌رغم وجود HfB_2 ، فاز سفید و سفید متمایل به خاکستری مشاهده نمی‌شود. به منظور بررسی این تفاوت‌های ریزساختاری، کامپوزیت‌های ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۷ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. برای این منظور از آنالیز

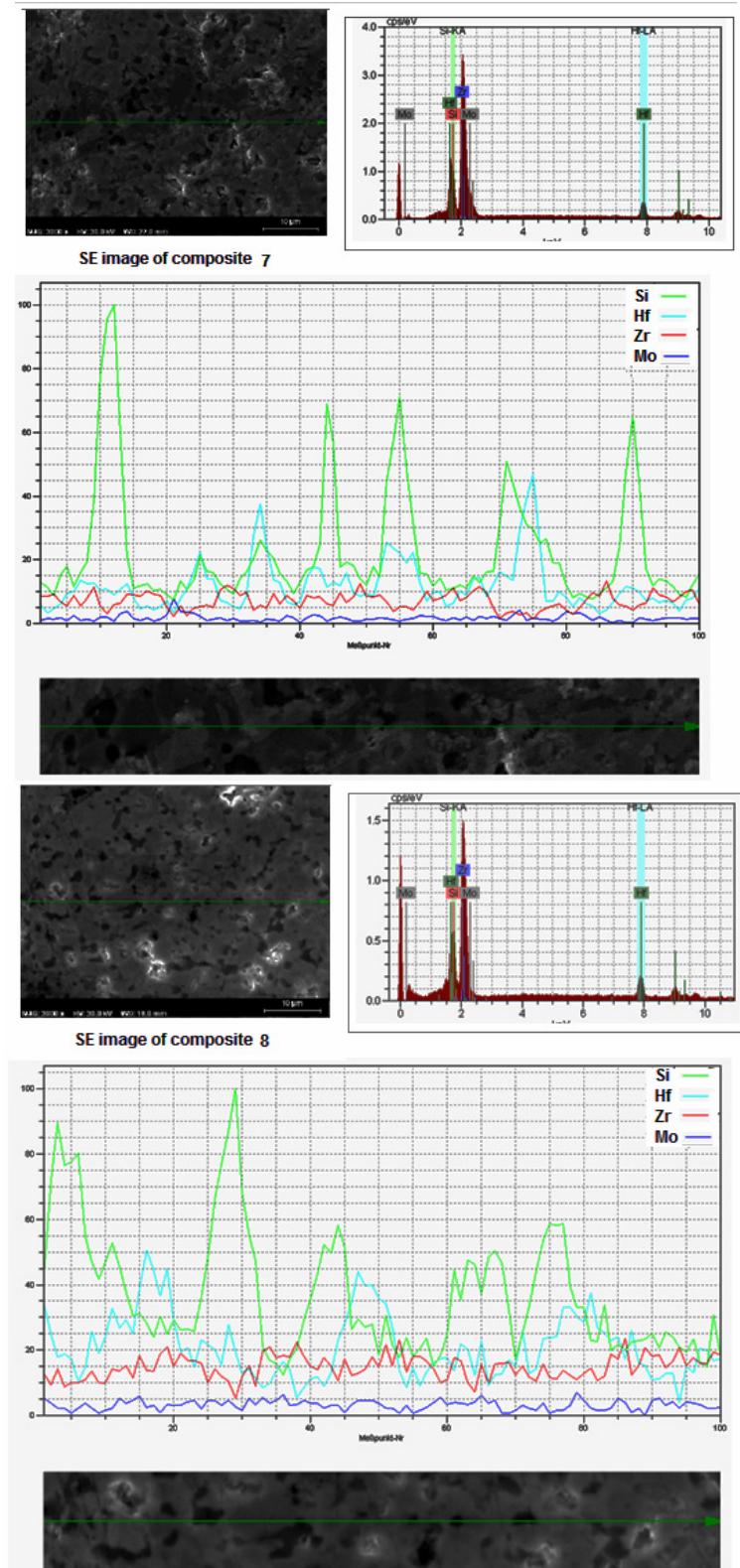


روشن در کامپوزیت ۴ نسبت به ۹ می‌شود. این امر با توجه به جدول ۲ به دمای سینتر بالاتر کامپوزیت ۴ (1900°C) نسبت به ۹ (1700°C) نسبت داده می‌شود. چرا که با افزایش دمای سینتر، میزان نفوذ و در نتیجه تشکیل محلول جامد افزایش می‌یابد.

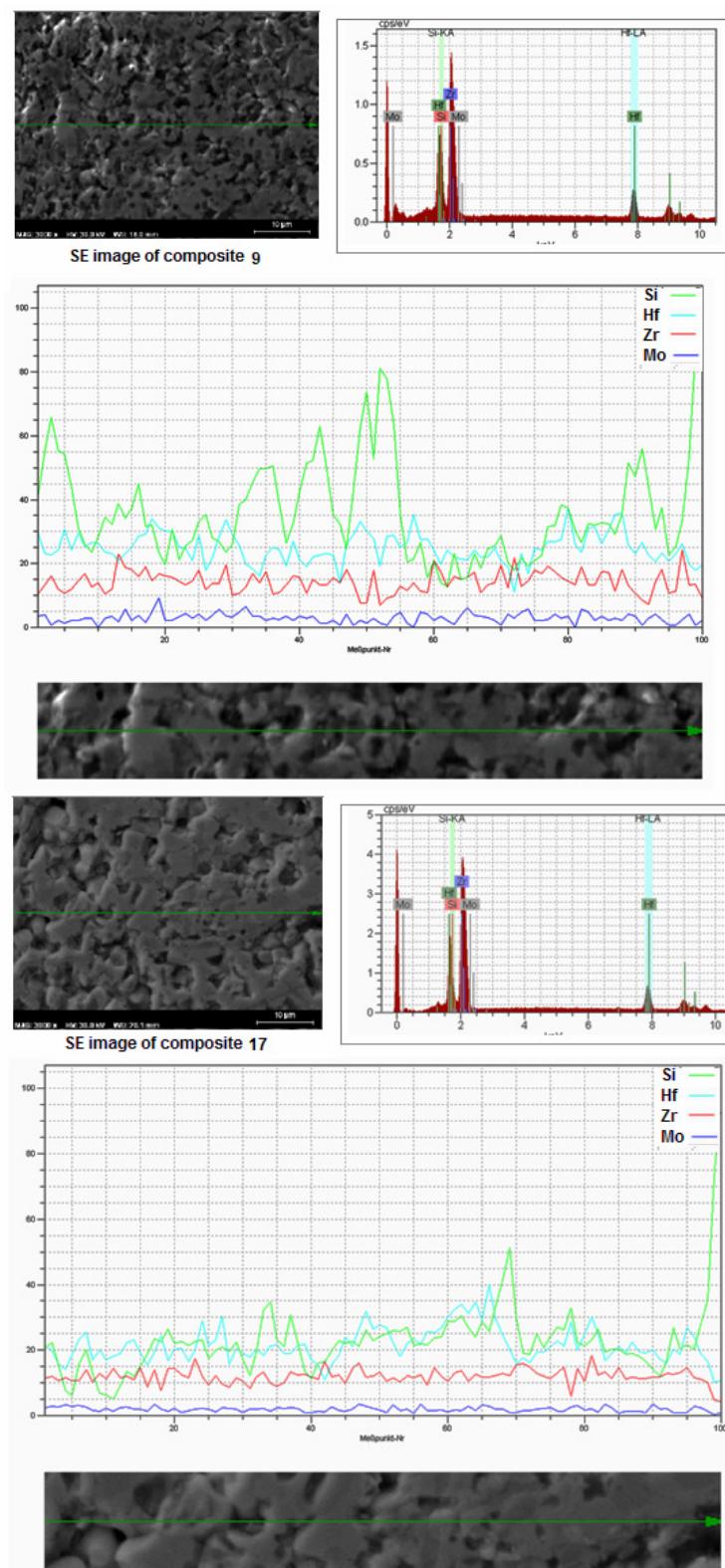
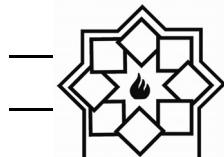
تیره، دانه‌های خاکستری روش وجود دارند، در حالی که در کامپوزیت ۹، دانه‌های خاکستری تیره مشاهده می‌شوند. این مسئله نیز مؤید حلایت بیشتر Hf در Zr در کامپوزیت ۴ نسبت به ۹ است. در واقع حلایت Hf در Zr سبب روش‌تر شدن رنگ آن و در نتیجه مشاهده دانه‌های خاکستری



شکل ۵- آنالیز خطی کامپوزیت‌های ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۷



ادامه شکل ۵- آنالیز خطی کامپوزیت‌های ۷، ۸، ۹ و ۱۷



ادامه شکل ۵- آنالیز خطی کامپوزیت‌های ۹، ۱۷ و ۱۸



جدول ۳ علت این مسئله را می‌توان به حضور فاز MoSi₂ در کامپوزیت ۸ نسبت به ۲۲ دانست. براساس نتایج گزارش شده توسط سایر محققین، Mo در Zr حل شده و سبب انقباض شبکه کریستالی Zr و تشکیل محلول جامد (B) (Mo) می‌شود[۹]. در این تحقیق نیز به منظور بررسی حل شدن Mo، پارامتر شبکه دو کامپوزیت ۵ و ۱۱ با نرم‌افزار Maud اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزودن MoSi₂ در کامپوزیت ۵ نسبت به ۱۱، شبکه کریستالی ZrB₂ دچار انقباض می‌شود ($a_5 = ۳/۱۶۸۲۴۷$ ، $c_5 = ۳/۵۳۶۸۳$ ، $a_{11} = ۳/۱۶۸۳۹۲$ ، $c_{11} = ۳/۵۳۰۵۵۳$) که بیانگر حل شدن MoSi₂ در ZrB₂ می‌باشد. به علاوه براساس مطالعات Kuzenkova [۱] حضور Mo فرآیند نفوذ را تسريع می‌نماید. با توجه به نتایج سایر محققین می‌توان نفوذ بیشتر صورت گرفته در کامپوزیت ۸ را به حضور MoSi₂ نسبت داد.

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در کامپوزیت‌هایی که میزان HfB₂ زیاد و دما (۱۶۰۰ °C) یا زمان (۴ min) سینتر پایین می‌باشد (به عنوان مثال کامپوزیت ۲۲)، با توجه به رابطه (۱) که بیانگر رابطه معکوس ضربی نفوذ با دما می‌باشد، امکان نفوذ فاز ZrB₂ HfB₂ در فراهم نبوده و این فاز به صورت تقریباً خالص بوده و به رنگ سفید در ریزساختار مشاهده می‌شود. با افزایش دما (۱۷۰۰ °C و بیشتر) و زمان (فرامن شدن شرایط لازم جهت نفوذ) میزان نفوذ این دو فاز در هم بیشتر شده و با توجه رنگ خاکستری تیره ZrB₂ از روشنی فاز HfB₂ کاسته شده و این فاز به رنگ سفید متمایل به خاکستری مشاهده می‌شود (تصاویر SEM کامپوزیت‌های ۸ و ۲۲ در شکل ۱). در

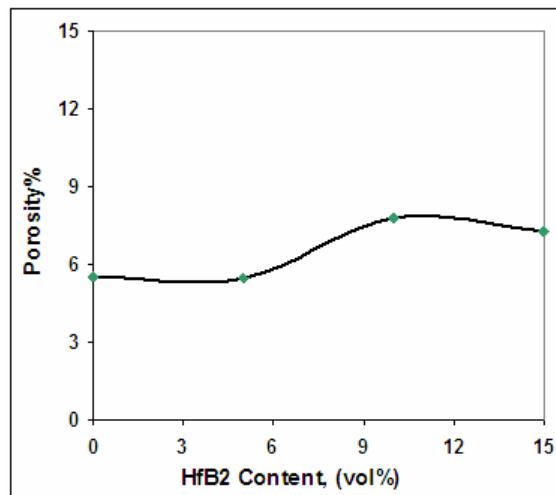
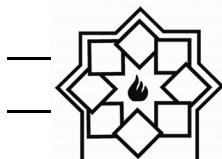
۳-۳- تأثیر زمان بر حلالت HfB₂

با توجه به شکل ۱ مشاهده می‌شود که تصاویر BSE کامپوزیت‌های ۸ و ۹ با هم تفاوت زیادی دارند (شکل ۱). در کامپوزیت ۸ دانه‌های ZrB₂ خالص بیشتری مشاهده می‌شود. به علاوه در این کامپوزیت اختلاف رنگ بین فازها بیشتر از کامپوزیت ۹ می‌باشد. با توجه به مطالب ارائه شده در بالا، می‌توان نتیجه گرفت که میزان حلالت Hf در کامپوزیت ۸ کمتر از کامپوزیت ۹ می‌باشد. اختلاف بیشتر مشاهده شده بین شدت پیک‌های آنها در کامپوزیت ۸ نسبت به ۹ (شکل ۷-۴) نیز مؤید این مطلب است. با توجه به جدول ۲ علت آن، زمان بیشتر سینترینگ کامپوزیت ۹ (16 min) نسبت به کامپوزیت ۸ (16 min) و در نتیجه نفوذ بیشتر می‌باشد.

در کامپوزیت‌های ۱۷ و ۲۲ نیز تفاوت‌های اشاره شده در بالا (دانه‌های ZrB₂ و اختلاف رنگ بیشتر در کامپوزیت ۲۲ نسبت به ۱۷) مشاهده می‌شود که ناشی از دما و زمان سینتر بیشتر در کامپوزیت ۱۷ است. آنالیز خطی این کامپوزیت‌ها نیز این مطلب را تأیید می‌نماید.

۴-۳- تأثیر فشار بر حلالت HfB₂

با مقایسه تصاویر BSE (شکل ۱) و آنالیز خطی (شکل ۵) کامپوزیت‌های ۸ و ۲۲، مشاهده می‌شود که علی‌رغم فشار سینترینگ بیشتر در کامپوزیت ۲۲، (دما و زمان ثابت)، میزان ZrB₂ در آن بیشتر است. به عبارت دیگر نفوذ انجام شده در این کامپوزیت کمتر از کامپوزیت ۸ می‌باشد. اختلاف زیاد شدت پیک‌های Zr و Hf در کامپوزیت ۲۲ نسبت به ۸ نیز تأیید کننده این مطلب است. با توجه به

شکل ۶- تأثیر HfB_2 بر درصد تخلخل‌های باز

۴- نتیجه‌گیری

- نتایج نشان داد که Zr و Hf در هم نفوذ کرده و تشکیل محلول جامد $(\text{Zr}, \text{Hf})\text{B}_2$ می‌دهند. با افزایش دما و زمان سینتر، میزان نفوذ و در نتیجه محلول جامد افزایش می‌یابد.
- در محدوده ذکر شده و در سیستم مورد مطالعه فشار تأثیر بسیار کمتری نسبت به دما و زمان بر فرآیند نفوذ دارد.
- حضور MoSi_2 سبب تشکیل یک فاز مایع شده که به نوبه خود سبب تسهیل فرآیند نفوذ می‌شود.
- نتایج نشان داد که افزودن HfB_2 سینترپذیری ZrB_2 را بهبود نداده و به میزان اندکی سبب افزایش درصد تخلخل‌های باز می‌شود.

مراجع

- [1] S. Guo, Densification of ZrB_2 -based composites and their mechanical and physical properties: A review, *J. of the Eur. Cer. Soc.*, Vol. 29, Pp. 995–1011,

نهایت با افزایش بیشتر دما و زمان (دما و زمان کافی جهت انحلال کامل دو فاز در هم) دو فاز به طور کامل در هم حل شده و به رنگ خاکستری روشن مشاهده می‌شوند (تصاویر SEM کامپوزیت‌های ۹، ۱۰ در شکل ۱).

$$D=D_0 \exp(-Q/RT) \quad (1)$$

۵-۳- تأثیر HfB_2 بر سینترپذیری

به منظور بررسی سینترپذیری کامپوزیت‌ها، چگالی تمامی ASTM C 373-088 استاندارد طبق استاندارد رخ داده چگالی اندازه‌گیری شد. به دلیل تحولات فازی رخ داده چگالی نسبی تعدادی از کامپوزیت‌ها بالای ۱۰۰ به دست آمد. از این‌رو، از درصد تخلخل‌های باز به عنوان معیاری برای ارزیابی سینترپذیری استفاده شد. به منظور مشخص نمودن تأثیر HfB_2 بر سینترپذیری ZrB_2 و رسم منحنی آن، از تحلیل ANOV استفاده شد. منحنی اثر HfB_2 بر درصد تخلخل‌های باز در شکل ۶ ارائه شده است. مشاهده می‌شود که در ابتدا با افزایش HfB_2 ، درصد تخلخل‌های باز به میزان کمی افزایش یافته و سپس تغییر محسوسی نمی‌نماید. با توجه به دیاگرام فاز سه‌تایی $\text{Zr}-\text{Hf}-\text{B}$ [۱۰] افزودن HfB_2 با هر نسبتی به ZrB_2 سبب تشکیل محلول جامد $(\text{Zr}, \text{Hf})\text{B}_2$ می‌شود. براساس مطالعات Rudy [۱۰] با افزایش میزان HfB_2 ، نقطه ذوب محلول جامد $(\text{Zr}, \text{Hf})\text{B}_2$ به طور قابل توجهی تغییر نمی‌کند که با نتایج Rudy سازگاری دارد. این امر ناشی از نزدیک بودن نقطه ذوب آن‌ها می‌باشد (ZrB_2 , 3245°C , HfB_2 , 3380°C). به عبارت دیگر افزودن HfB_2 سبب کاهش نقطه ذوب ZrB_2 نمی‌شود و نقش کمک سینتر ندارد و از این‌رو به میزان اندکی درصد تخلخل‌های باز را افزایش می‌دهد.



- [11] S. Guo, Y. Kagawa, T. Nishimura, D. Chung, J. M. Yang, Mechanical and physical behavior of spark plasma sintered ZrC–ZrB₂–SiC composites, *J. of the Euro. Cera. Soci.* 28 (2008) 1279–1285
- [12] S. Guo, Densification, microstructure, elastic and mechanical properties of reactive hot-pressed ZrB₂–ZrC–Zr cermets, *Journal of the European Ceramic Society* 34 (2014) 621–632
- [2] 2009.
- [3] R. Licheri, R. Orrù, C. Musa and G. Cao, Combination of SHS and SPS Techniques for fabrication of fully dense ZrB₂-ZrC-SiC composites, *Mate. Lett.*, Vol. 62, Pp. 432–435, 2008.
- [4] M. R. George, Studies of ultra high temperature ceramic composite components: synthesis and characterization of HfO_xC_y and Si oxidation in atomic oxygen containing environments, P.H.D Thesis, Vander bilt university, 2008.
- [5] M. J. Gasch, D. T. Ellerby and S. M. Johnson, "Ultra High Temperature Ceramic Composites", Pp. 197-226 in *Handbook of Ceramic Composites*, Edited by N. P. Bansal, NASA Glenn Research Center, USA, 2005.
- [6] A. Rezaie, W.G. Fahrenholtz , G. E. Hilmas, Effect of hot pressing time and temperature on the microstructure and mechanical properties of ZrB₂–SiC, *J. Mater. Sci.*, Vol. 42, Pp.2735–2744, 2007.
- [7] N. B. Maheswaraiah, Processing of ZrB₂–ZrC-Zr_xSi_y ceramic by reactive metal penetration, Master of science, university of texas, 2010.
- [8] M. Tokita, Mechanism of Spark plasma sintering, Kanagawa 213 Japan.
- [9] W. W Wu, G. J. Zhang, Y. M. Kan, P. L. Wang, K. Vanmeensel, J. Vleugels and O. Van der Biest, Synthesis and microstructural features of ZrB₂–SiC-based composites by reactive spark plasma sintering and reactive hot pressing, *Scr. Materi.* Vol. 57, Pp. 317–320, 2007.
- [10] ASTM C 373-88: Standard Test Method for Water Absorption, Bulk Density, Apparent Porosity, and Apparent Specific Gravity of Fired Whiteware Products, 2006.
- [11] E. Rudy, Ternary phase equilibria in transition-metal-boron-carbon-silicon systems, part V, compendium of phase diagram data, 1969, Pp. 562-581.